

単位: mm

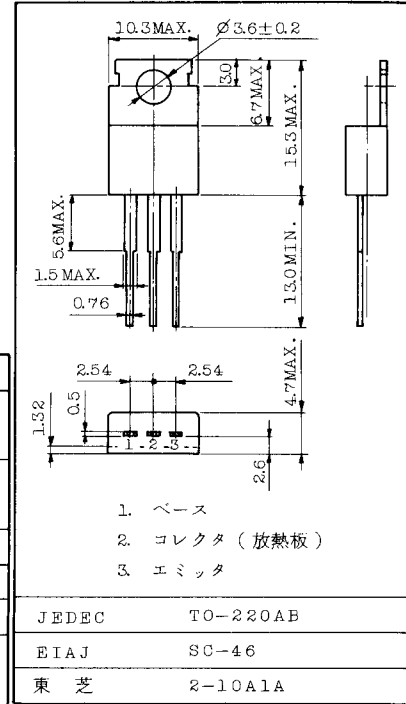
○ 低周波電力増幅用

特長

- 飽和電圧が低い。  
 $V_{CE(sat)} = -1.2V$  (最大) ( $I_C = -3A$  (2SB434))  
 $V_{CE(sat)} = -1.0V$  (最大) ( $I_C = -1A$  (2SB435))
- 許容コレクタ損失が大きい。:  $P_C = 25W$  ( $T_c = 25^\circ C$ )
- 2SD234, 2SD235 とコンプリメンタリになります。

最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	定格	単位	
コレクタ・ベース間電圧	2SB434 2SB435	$V_{CBO}$	-50 -40	V
コレクタ・エミッタ間電圧	2SB434 2SB435	$V_{CEO}$	-50 -40	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-5	V	
コレクタ電流	$I_C$	-3	A	
ベース電流	$I_B$	-0.3	A	
コレクタ損失	$T_a = 25^\circ C$	$P_C$	1.5	W
	$T_c = 25^\circ C$		25	
接合温度	$T_j$	150	$^\circ C$	
保存温度	$T_{stg}$	-55~150	$^\circ C$	



アクセサリはAC55Cを適用

電気的特性 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
コレクタしゅ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -30V, I_E = 0$	—	—	-10	$\mu A$
エミッタしゅ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	-100	$\mu A$
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	2SB434	$V_{(BR)CEO}$ $I_C = -100mA, I_B = 0$	-50	—	—	V
	2SB435		-40	—	—	
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 10mA, I_C = 0$	-5	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (注)	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	40	—	240	
直流電流増幅率	2SB434	$h_{FE(2)}$ $V_{CE} = -5V, I_C = -2.5A$	15	60	—	
	2SB435		20	90	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	2SB434	$V_{CE(sat)}$ $I_C = -3A, I_B = -0.3A$	—	-0.6	-1.2	V
	2SB435		$I_C = -1A, I_B = -0.05A$	—	-0.2	
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	—	-0.75	-0.9	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = -5V, I_C = -0.5A$	—	10	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	150	—	pF

注:  $h_{FE(1)}$  分類 R: 40~80, O: 70~140, Y: 120~240